

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成26年5月1日(2014.5.1)

【公開番号】特開2012-209421(P2012-209421A)

【公開日】平成24年10月25日(2012.10.25)

【年通号数】公開・登録公報2012-044

【出願番号】特願2011-73925(P2011-73925)

【国際特許分類】

H 01 L 27/146 (2006.01)

H 04 N 5/369 (2011.01)

【F I】

H 01 L 27/14 E

H 04 N 5/335 6 9 0

【手続補正書】

【提出日】平成26年3月14日(2014.3.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0037

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0037】

このように、光電変換膜56が導波路構造となっていることで、集光特性の向上、特に、斜め入射光に対する感度の向上を図ることができる。そして、導波路構造の光電変換膜56は、上部電極57に対して第1の配線60を通してバイアス電圧(図1のバイアス電圧Vbias)が印加されることで、入射光中のG光については吸収して光電変換を行う一方、G光以外の波長域の光については透過する。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0059

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0059】

上記の画素構造の単位画素50cにおいて、第1の光電変換膜56Aによる光電変換によって得られる電荷は、第1の下部電極55Aによって読み出され、第2の一方の配線61Aを通して、シリコン基板51内に形成された電荷蓄積部64Aに蓄積される。また、第2の光電変換膜56Bによる光電変換によって得られる電荷は、第2の下部電極55Bによって読み出され、第2の他方の配線61Bを通して、シリコン基板51内に形成された電荷蓄積部64Bに蓄積される。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0070

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0070】

<3.電子機器>

本開示は、固体撮像装置への適用に限られるものではなく、デジタルスチルカメラやビデオカメラ等の撮像装置や、携帯電話機などの撮像機能を有する携帯端末装置など、画像取込部(光電変換部)に固体撮像装置を用いる電子機器全般に対して適用可能である。画

像取込部に固体撮像装置を用いる電子機器には、画像読取部に固体撮像装置を用いる複写機も含まれる。尚、電子機器に搭載される上記モジュール状の形態、即ちカメラモジュールを撮像装置とする場合もある。

【手続補正4】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図 8】

